大型放射光施設計画(I)

日本原子力研究所・理化学研究所 大型放射光施設研究開発共同チーム

上坪 宏道

1. はじめに

日本原子力研究所(原研)・理化学研究所(理 研)の大型放射光施設計画は,短波長領域(軟X 線~硬X線)に重点を置いた高性能放射光源を兵 庫県西播磨の播磨科学公園都市に建設しようとい うもので,完成の暁には,大学,国公立研究機関 及び産業界の共同利用に供するとともに,積極的 に国際的研究交流の場にして,基礎的,先導的研 究の振興を図ることを目指している。この計画を 実現するため,1986年から設計研究及び要素技術 の開発研究が進められてきた。さらに1988年10月 には,両研究所の関係者が「大型放射光施設研究 開発共同チーム」を結成し,1990年度建設開始に 向けて準備を進めている。

本稿では、まずこれまでの経緯を簡単に述べ、 次いで必要な光源の条件、計画の概要、建物及び 敷地計画、建設年次計画の概要を記すことにした。 加速器(入射器及び蓄積リング)の詳細は別に大 型放射光施設計画(II)として本誌に発表する予 定である。

2. これまでの経緯

高エネルギー物理学研究所(KEK)放射光実 験施設(PF)完成後,放射光研究者者のグルー プで次期計画の検討が進められてきた。ここでは その経緯にはふれず,科学技術庁(科技庁)にお ける放射光施設(SR)計画の推移を簡単に記すこ とにしたい。

科技庁の「航空・電子等技術審議会」はその第 9号答申(昭和61年3月)「新材料研究開発に係 わる計測及び制御技術の高度化のための重点課題 及びその推進方策について」において,大型・高 度化施設の整備を推進すべき方策にあげ,大型 SR をその一つに加えた。同審議会はさらに第11 号答申(昭和62年7月)「光科学技術の高度化に 関する総合的な研究開発の推進について」で,推 進すべき重要研究課題の第一に大型SRの開発を あげて,基礎的創造的研究開発を推進する上で重 要な研究基盤となる大型SRの整備を提案した。 一方,原子力委員会も昭和62年6月策定の「原子 力開発利用長期計画」において,先導的プロジェ クトの推進策として新しいビームの利用技術・発 生技術の研究開発をあげ,放射光利用を加えた。

一方,理研では昭和51年にラジエーションサイ エンスセンター計画が提案され,リングサイクロ トロンと1~2 GeVのSR を建設する計画が検討 された。その後国際フロンティア研究システムの 設置にあたって,その研究設備として1.5GeVSR も検討されている。さらに理研は,今後の光科学 総合研究推進方策を検討し,新規施策として「光 総合研究の推進:6 GeV-SR 開発計画」を昭和 61年4月に提案した。

昭和62年度には、大型放射光施設研究開発予算 が理研に認められ、同時に科技庁に高エ研、大学 及び関係省庁、民間の専門家を委員とする「大型 放射光施設整備連絡協議会」が設置された。同協 議会は5回にわたる討議の後、短波長を指向した 高輝度放射光源の必要性を認め、6GeVクラス の高輝度光源の建設を提言した。さらに、その建 設に当たっては広く学識経験者、利用研究者 の意見を聞くとともに、KEKなどの経験を十分 に生かし、また人材確保・人材育成も行なってい く必要があると指摘した。これをうけて原研、理 研では、大型放射光施設計画に関した重要事項の 検討・評価を行うため、学識経験者を集めた「大 型放射光施設計画検討委員会」(検討委員会)を 平成元年5月に設置した。この委員会には「加速 器小委員会」「利用小委員会」が設けられており, それぞれ加速器システムの技術的な検討・評価, 利用計画の策定及び関連する開発研究計画の検討 ・評価を行っている。一方、科技庁ではこの計画 に対して大所高所からの意見を求めるため、「大 型放射光施設整備懇談会」を9月に発足させた。 また、将来この施設を利用する予定の研究者が集 まり,「次世代大型X線光源研究会」(代表 菊田 **惺志・東大教授, 菊田研究会と略す) をつくり,** 具体的な研究計画の検討を進めている。

一方,大型放射光施設の建設場所を選定するため,科技庁は昭和63年2月に「大型放射光施設立 地選定指針検討委員会」を設置した。委員会はま ず立地選定指針をつくり,4候補地について実地 調査を含めて審議を重ね,最終的に兵庫県西播磨 の「播磨科学公園都市」を建設場所に選定した。

X線を主体とする高輝度放射光源の建設計画は, ヨーロッパ,アメリカで早くから検討されており, 相次いで建設が開始されている。ヨーロッパでは, Grenoble にヨーロッパ連合のESRF(European Synchrotron Radiation Facility)が建設され 始めており,アメリカではArgonneにAPS (Advanced Photon Source)の建設が始まった。 我々の計画はこれらに続くものである。なお最近, 大型放射光施設の愛称をSPring-8(Super Photon Ring-8GeV)とすることになった。

3. 必要な光源の条件

大型放射光施設は,X線を主体とする高輝度・ 短波長放射光の利用を目的としている。その目標 とする特徴は,1)挿入光源を放射光の主要な発 生源にしていて,2)X線領域で放射光の輝度が 極めて高く,3)安定性の高いことである。換言 すれば、ミクロン程度の微小試料の測定やミリ秒 以下の時間分解能での測定ができるように、輝度 (Brilliance)が充分高いこと、核共鳴吸収など 起こる確立の低い現象の研究や微量物質の蛍光X 線分析などを比較的短時間で行うために、単位面 積に来る光子数が多いこと、トポグラフィーや小 角散乱のような測定で充分な分解能を得るため、 X線の平行度が高いこと等が要求されている。

計画立案に当たっては、まずどの様な挿入光源 が将来使われるかを検討した。後述するように、 本計画は最も順調に進んでも、蓄積リングに電子 ビームを入射するのは1995年の終りである。それ までには挿入光源の研究も進み、現在より数段も 性能の優れた挿入装置が開発される可能性も高い。 我々は種々検討の結果、

①既に実用化しているアンジュレーター

②マイクロアンジュレーター

の2つを想定して設計を進めることにした。とく に,施設が完成する頃には②も実用化され,特別 長い挿入光源は必要がなくなると判断して,挿入 光源を設置する直線部の長さを6m程度として 設計を進めた。事実,ESRF, APS も特に長い 直線部は設けてはいない。

しかし最近開かれた「検討委員会」で,もっと 長い直線部を設置すべきとの強い意見が出された。 これは将来,ビームのエミッタンスを極端に低く して,自由電子レーザーの開発やDiffraction Limit 近くの放射光を発生させる試みができる ようにしておくためである。また,少しでも輝度 あるいは光束を上げるため,①の場合でもすぐに 長い直線部が必要になるとの意見もあり,検討の 結果,30mの長直線部を4本設置することになっ た。

電子エネルギーは目的とする放射光X線の波長 領域によって決められる。これに関して「菊田研 究会」では、いろいろな研究分野で将来必要にな



第1図 研究分野別に必要とされる放射光の性能

ると思われるX線のエネルギーと光子数をまとめ た¹⁾。その結果を第1図に示した。主要な研究分 野が要求するX線のエネルギーは200keVに達し ており、必要とする光子数も非常に多い。我々は 当初6GeVで設計を進めていたが²⁾、通常型の 挿入光源(①)を用いて必要なエネルギーのX線 を得るためには、電子エネルギーは6GeVより 高くなければならない。第2図にNd-B-Fe 合 金系の永久磁石を用いた周期長2.5cmのアンジュ レーターで得られるX線のエネルギーを示した。 主要元素のK吸収端の値を右側に示す。Z=40~ 50の元素のK吸収端(25keV)ぐらい迄を1次光 で得ようとすると、電子エネルギーは8GeVが 必要である。以上の結果を勘案して、「検討委員 会」は電子エネルギーを8GeVとすることを決 めた。



Undulator 2.5cm



第2図 Nd-B-Fe 合金系の永久磁石を用いた周期長2.5 cmアンジュレーターで得られるX線のエネル ギー磁場の強さは下の式で与えられると仮定し た。

一方, **第1図**で見られるように試料上で単位面 積当りに要求される光子数は極め多い。これらの 要求を実現するには, X線の輝度(Brilliance) が十分高く, 波長領域によっては10¹⁹(photons/ s.mm²・rad²・0.1%b.w.) 以上なければならな い。

4 . SPring - 8 の概要

前節で述べたような要求が満たされるためには 蓄積リングの電子ビームのエミッタンスを極力低 くした,いわゆる低エミッタンスリングを建設し なければならない。そのためには蓄積リングの磁 石配列の基本構成(ラティス)を,強集束の Chasman – Green(CG)型かTriple–Bend Achromat(TBA)型にすることが望ましい。 我々は種々検討の結果³⁰,諸外国で行われている CG 型ラティスを採用して設計を行った。設計目 標とするエミッタンスは、5~10nm・radであ る。 一方,輝度は蓄積電流に比例して高くなる。
 PFリングの蓄積電流は500mAに達している⁴⁾ も
 しこれと同じ電子数を蓄積するとすれば,SPring
 8では電流値が約7分の1の70mA 程度になる。
 そこで蓄積電流の目標は100mAとした。

放射光の利用にあたっては,光源の位置が動か ず,強度の変動が少ないことが要求される。その ためには蓄積リングを光源にし,電源等の安定度 を高くするとともに,建物等の変位,変形の影響 を受けにくくすること等が必要である。しかし, 安定な光源を実現する条件がすべて明らかになっ ているとはいい難い。

安定な電子ビーム軌道を実現するためには,全 エネルギー入射方式が優れている。そこで我々は 電子リニアック(1GeV)とシンクロトロン(8 GeV)及び8GeV 蓄積リングを配した複合加速 器システムを建設することにした。蓄積粒子とし ては,陽電子が不安定性を避ける上で優れている といわれている⁵⁾。一方,これまでのPFの経験 では陽電子の優位性は疑問視されている⁶⁾。そこ で我々は当面電子を蓄積し,その後,陽電子を使 用している施設での進展を参考にして,陽電子を 主要な蓄積粒子とするよう検討を進めることにし た。

SPring - 8 各加速器の主要パラメータを第一 表に示した。電子リニアックに要求される性能は、 繰り返し周波数が60Hz,平均ピーク電流が電子 で100mA (陽電子で10mA),パルス幅が蓄積リ ング単バンチ運転の場合に1 ns,多バンチ運転 の場合には1 μ s (陽電子で10ns)である。この ほか陽電子発生用に250MeV の大電流電子リニ アックが別途必要になる。

シンクロトロンはセル数40のFODO 型ラティ スとし、入射、取り出し用にそれぞれ偏向磁石を 6個づつ抜いた直線部を2箇所設けた。なお加速 高周波空洞もこの直線部に設置する。加速RFの 周波数にはKEKトリスタンと同じ508.6MHzを 採用し、加速空洞として、多連セル型のものを開

第1表 大型放射光施	题(SPring-8)を構成する加速
器の概要	
入射器	
1. 電子リニアック	
到達エネルギー:	1 GeV
加速粒子:	電子,陽電子
平均ピーク電流:	100mA(電子), 10mA(陽電子)
パルス幅:	1ns/1 <i>µ</i> s(単バンチ/多バンチ, 電子)
	1ns/10ns(同上、陽電子)
繰り返し率:	60Hz
2. シンクロトロン	
最大エネルギー:	8 GeV
ラティス:	FODO型、40セル
直線 部 :	2 箇所
偏向磁場:	0.9T (8GeV)
R F 周 波 数 :	508.6MHz
周長:	396 m
ハーモニック数:	672
繰り返し率:	1 Hz
最大電流:	10m A
素積リング	
エネルギー:	8 GeV
ラティス:	Chasman-Green型, 48セル 通常セル 44 直線セル 4
直 線 部 :	6.5m 40箇所 30m 4箇所
偏向磁場:	0. 67 T
R F 周 波 数 :	508.6 MHz

周 長 : 1436m ハーモニック数: 2436 蓄 積 電 流 : 100mA(多バンチ) 5mA(単バンチ)

発中である。またハーモニック数を672,周長を 396mとし,繰り返し周波数は1Hzに決めた。

蓄積リングは第3図(a)の磁石配置を単位セルと したCG型ラティスである。直線部分の長さを 6.5mにとって設計を進めた。前節で述べたよう に、当初は48セルがすべて同等の構成になってい て、β関数が交互に大小の値を持つようにした スーパー周期数が24のラティスであった。その後 長直線部の必要性が「検討委員会」で議論された ので、ビーム運動学的解析を行なった。その結果、 偏向磁石を取り去った直線セルを作れば、約30m の長直線部が実現でき、エミッタンスやダイナ ミックアパーチャーがあまり悪くならないことが 明らかになった。この長直線部には当初、4極磁 石、6極磁石を通常セルと同じに配置し(第3図 (b))、運転実績を積んでから改めて4極磁石、6 極磁石を配置しなおして30mの直線部を実現する ことにした。これらのラティスについて、低エミッ タンス運転の場合の単位セルの磁石配置と、ベー タトロン関数 β_x 、 β_y および分散 η を第4図に示 した。図には当初案(通常セルのみ)を(a)、通常 セルと同じ構成の直線セルを(b)、最終案の長直線 セルを(c)として示してある。偏向磁石数が減少し た分だけ(b)、(c)はエミッタンスが悪くなっている が、目標値の範囲内である。

ベータトロン関数の値についても検討した。一 般に通常型アンジュレータの設置場所ではビーム の平行度が高い方が望ましく、多極のウィグラー やマイクロアンジュレータを設置する所では、電 子ビームはできるだけ細い方がよい。そのために は前者の設置場所では β 関数を大きく、後者の場 所では小さくする。この両方の要求を満たすため、 直線部では交互に高 β と低 β になるように設計を 進めた。第4図に示したように、通常セルでは β_x が交互に大きい値と小さな値を取るようにし た。

一方,このリングについてシミュレーションで 求めたダイナミックアパーチャーは、リングの真 空チェンバーを十分に越す大きさになっており、 優れた性能の低エミッタンスリングになっている。 しかし、このリングには88個の偏向磁石、500近 い4極磁石と350を越す数の6極磁石が周長約1.5 kmに亘って配置されている。この配列誤差や磁場 の不均一がダイナミックアパーチャーを小さくす るので、これまで以上に磁石の製作精度、配列の 精度を上げる努力が必要である。

蓄積リングの加速周波数は、シンクロトロンと 同じく508.6MHz で、ハーモニック数は2436、



ONE CELL OF THE 8GeV STORAGE RING (NORMAL CELL)

E=8GeV B=0.665T CELL ND=44 BENDING RAD=40.098M

(a)



DNE CELL DF THE 8GeV STDRAGE RING (STRAIGHT CELL)

E=8GeV CELL ND=4

(b)

第3図 蓄積リングの単位セル 上図(a)は通常セルで、下図(b)は偏向磁石2個を除いて直線部とし、そこに挿入光源を配 置した直線セルである。

第4図 蓄積リングのベータトロン関数と分散 上図(a)は48個の通常セルで構成したラテイス、中図(b)は偏向磁石を2個取り除いて長直線部を4箇所作ったラテイス、下図(c)は長直線部のQ電磁石を再配置して30mの直線部にしたラテイスについての計算値である。



放射光 第2巻第4号



その周長は1436mである。加速高周波電圧は16 MVが必要で、そのためにシングルセル型加速空 洞を40個程度は設置しなければならない。シング ルセルを採用したのは高調波成分による不安定性 を避けるためであり、加速空洞については、現在 モデル空洞を製作して静的特性の測定およびパ ワーテストを行なう準備をしている。

蓄積リングは多バンチ運転と単バンチ運転を予 定しており,それぞれの場合に目標としている最 大蓄積電流は100mA,5mAである。シンクロ トロン,蓄積リングへの入射効率を100%と仮定 した場合の入射時間を第2表に示した。多バンチ 運転で電子を蓄積する場合は、リニアックでパル ス幅1μsの電子ビームを加速し、シンクロトロ ンにそのまま入射・加速して蓄積リングへ移す。 一方、陽電子の多バンチ運転と電子・陽電子の単 バンチ運転では、シンクロトロンに等間隔に8パ ルス入射し1Hzの繰り返しで加速した後、蓄積 リングへ入射する。実際には入射効率は低くなる ので、入射に要する時間は第2表の値より長くな るが、電子銃からの電流値を増やすこと、陽電子 の収集効率を上げることなどの対策を講じて、入 射の所用時間が10分以内になるよう研究開発を進 める計画である。

第2表 蓄積リングへの入射時間

 ・ライナックからシンクロトロンへの入射効率、シンクロトロンからストレージリングへの入射効率は 100%を仮定。

thr	Ħ					入	射	方	式	
海	Ш	ストレー		エネルギ	8	パルス・1	Hz	1	パルス・1	Hz
^远 粒 子	途	ジリング 蓄積電流 [mA]	ライナックからの パルス波形	アクセブ タンス [%]	シンクロ トロン 最大電流	ストレー ジリング 入射繰り 返し回数	ストレー ジリング 入射時間 [秒]	シンクロ トロン 最大電流	ストレー ジリング 入射繰り 返し回数	ストレー ジリング 入射時間 [秒]
電子	マルチバンチ	100	ΨΨΟ? /.3 μs	50		\searrow		10mA	36	36
陽 電 子	マルチバンチ	100	V m 01 10ns	50	300 µA	1200	1200	38 µA	9600	9600
電子	シングルバンチ	ភ	VH 0000 ~1 ns	100	1.8mA	10	10	230 μA	80	80
陽 電 子	シングルバンチ	5	Vm0F~1ns	100	61 µA	300	300	7.6 μΑ	2400	2400

(アンジュレータは全長4m,ギャップを変えたときのピークを示している。)



SPECTRAL BRILLIANCE

第5図 期待される放射光のスペクトル輝度 アンジュレーターのスペクトルは、左から右へ周期長が短くなっている。

第3表 高輝度高エネルギー放射光施設の比較

エネルギー(GeV)867ビーム(mA)100100100偏向磁石軌道半径(m)40.124.9638.96偏向磁场(T)0.670.80.6周長(m)1436844.41104ペリオディシティー24 (4)32 (16)40エミッタンス(nmrad) x 平6.536.198.0垂直0.650.620.8ビームの大きさ (mm) (水平×垂直) $-$ 0.402×0.0810.406×0.0840.32×0.0ウィグラー0.085×0.0610.069×0.0470.32×0.0偏向磁石 $-$ 0.160×0.129 $-$ ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) $ -$ アンジュレーター0.016×0.0080.010×0.007 $0.025×0.00$ ウィグラー0.016×0.0110.089×0.13 $0.025×0.00$ 加速間波数(MHz)508.58259.651.00		SPring-8	ESRF	APS
ビーム(mA)100100100偏向磁石軌道半径(m)40.124.9638.96偏向磁場(T)0.670.80.6周長(m)1436844.41104ペリオディシティー24 (4)32 (16)40エミッタンス(nmrad) x 平6.536.198.0垂直0.650.620.8ビームの大きさ (nm) (水平×垂直)0.402×0.0810.406×0.0840.32×0.0アンジュレーター0.402×0.0810.406×0.0470.32×0.0ウィグラー0.085×0.0610.069×0.0470.32×0.0偏向磁石-0.160×0.129-ビームの広がり (mrad) (水平×垂直)-0.016×0.0080.010×0.0070.025×0.0アンジュレーター0.016×0.0110.089×0.130.025×0.00.025×0.0ウィグラー0.077×0.0110.089×0.130.025×0.00.025×0.0	エネルギー(GeV)	8	6	7
偏向磁石軌道半径(m)40.124.9638.96偏向磁場(T)0.670.80.6周長(m)1436844.41104ペリオディシティー24 (4)32 (16)40エミッタンス(nmrad) x 平6.536.198.0垂直0.650.620.8ビームの大きさ (nm) (水平×垂直) x 0.406×0.0840.32×0.0アンジュレーター0.402×0.0810.406×0.0470.32×0.0「病甲磁石 $-$ 0.160×0.129 $-$ ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) $ -$ アンジュレーター0.016×0.0080.010×0.007 $0.025×0.0$ ウィグラー0.016×0.0080.010×0.0070.025×0.0ウィグラー0.077×0.0110.089×0.130.025×0.0	ビーム(mA)	100	100	100
偏向磁場(T) 0.67 0.8 0.6 周長(m)1436 844.4 1104 ペリオディシティー $24(4)$ $32(16)$ 40 エミッタンス(nmrad) x 平 6.53 6.19 8.0 垂直 0.65 0.62 0.8 ビームの大きさ (nm) (水平×垂直) 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 アンジュレーター 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 ヴィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 $ 0.160 \times 0.129$ $-$ ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) $ 0.016 \times 0.008$ 0.010×0.007 0.025×0.0 アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 0.025×0.0 フィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0	偏向磁石軌道半径(m)	40.1	24.96	38.96
周長(m) 1436 844.4 1104 ペリオディシティー 24(4) 32(16) 40 エミッタンス(nmrad) 水平 6.53 6.19 8.0 垂直 0.65 0.62 0.8 ビームの大きさ (nm) (水平×垂直) アンジュレーター 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 ウィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 - 0.160×0.129 - ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0	偏向磁場(T)	0.67	0.8	0.6
ペリオディシティー 24 (4) 32 (16) 40 エミッタンス(nmrad) 水平 6.53 6.19 8.0 垂直 0.65 0.62 0.8 ビームの大きさ (nm) (水平×垂直) アンジュレーター 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 ウィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 - 0.160×0.129 - ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速関波数(MHz) 508.58 259.9	周長(m)	1436	844.4	1104
エミッタンス(nmrad) 水平6.536.198.0垂直0.650.620.8ビームの大きさ (nm) (水平×垂直)0.402×0.0810.406×0.0840.32×0.0アンジュレーター0.402×0.0810.406×0.0470.32×0.0ウィグラー0.085×0.0610.069×0.0470.32×0.0偏向磁石-0.160×0.129-ビームの広がり (mrad) (水平×垂直)アンジュレーター0.016×0.0080.010×0.0070.025×0.0ウィグラー0.077×0.0110.089×0.130.025×0.0加速間波数(MHz)508.58350.0508.58	ペリオディシティー	24 (4)	32 (16)	40
水平6.536.198.0垂直0.650.620.8ビームの大きさ (mm) (水平×垂直) $(X = X = X = 0)$ 0.402×0.0810.406×0.0840.32×0.0ウィグラー0.402×0.0810.406×0.0470.32×0.0偏向磁石-0.160×0.129-ビームの広がり (mrad) (水平×垂直)アンジュレーター0.016×0.0080.010×0.0070.025×0.0ウィグラー0.016×0.0110.089×0.130.025×0.0加速周波数(MHz)508.58350.0350.0	エミッタンス(nmrad)			
垂直 0.65 0.62 0.8 ビームの大きさ (nm) (水平×垂直) 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 アンジュレーター 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 ウィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 $ 0.160 \times 0.129$ $-$ ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) $ 0.016 \times 0.008$ 0.010×0.007 0.025×0.0 アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速周波数(MHz) 508.58 250.0 951.02	水平	6.53	6.19	8.0
ビームの大きさ (nm) (水平×垂直) アンジュレーター 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 ウィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 - 0.160×0.129 - ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速周波数 (MHz) 508 58 250.0	垂直	0.65	0.62	0.8
アンジュレーター 0.402×0.081 0.406×0.084 0.32×0.0 ウィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 - 0.160×0.129 - ビームの広がり(mrad) (水平×垂直) - 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0	ビームの大きさ(mm) (水平×垂直)			
ウィグラー 0.085×0.061 0.069×0.047 0.32×0.0 偏向磁石 - 0.160×0.129 - ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速周波数(MHz) 508 58 250.0	アンジュレーター	0.402×0.081	0.406×0.084	0.32×0.09
偏向磁石 − 0.160×0.129 − ビームの広がり(mrad) (水平×垂直) アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速周波数(MHz) 508 58 250.0	ウィグラー	0.085×0.061	0.069×0.047	0.32×0.09
ビームの広がり (mrad) (水平×垂直) アンジュレーター 0.016×0.008 0.010×0.007 0.025×0.0 ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速周波数(MHz) 508.58 250.0	偏向磁石	_	0.160×0.129	
アンジュレーター0.016×0.0080.010×0.0070.025×0.0ウィグラー0.077×0.0110.089×0.130.025×0.0加速周波数(MHz)508.58250.0251.00	ビームの広がり(mrad) (水平×垂直)			
ウィグラー 0.077×0.011 0.089×0.13 0.025×0.0 加速周波数(MHz) 508 58 256.0 051.00	アンジュレーター	0.016×0.008	0.010×0.007	0.025×0.009
加速周波数(MHz) 508 58 250 8 051 00	ウィグラー	0.077×0.011	0.089×0.13	0.025×0.009
301.93 301.93 302.2 331.93	加速周波数(MHz)	508.58	352.2	351.93

本計画で期待される放射光のスペクトル輝度を 第5図に,また,ESRF,APSとの比較を第3 表に示した⁷⁾。長直線部を設置しても低エミッタ ンスリングの性能は他に比して遜色がない。

5. ビームラインと実験エリアの概要

前節で述べたように、蓄積リングには挿入光源 を設置できる直線部分として、長さ6.5mのもの が40箇所,長さ30mのものが4箇所ある。とこ ろが6.5mの直線部は入射に1箇所, RF空洞に 5箇所使用されるので、実際に挿入光源に利用で きるのは34箇所になる。一方,長直線部もマシン グループが2箇所使う計画なので,利用者に供さ れるのは2箇所になり、合計で36箇所が利用研究 に使用可能である。このほか偏向磁石からのビー ムラインを9本設置する計画なので,全体で45本 のビームラインが利用できることになる。しかし これについては「検討委員会」で、偏向磁石から もっと多くのビームラインをとれるようにしてお くべきとの意見があり、今後の検討課題になって いる。なお、加速器システムの建設完了時期まで には、約10本のビームラインを建設する予定で計 画を進めている。

ビームラインの長さは利用計画に密接に結びつ いており、そこに取り付けられる実験装置の大き さ、性能にも影響することが考えられる。しかし ビームラインが長くなれば建物が大きくなり、問 題を生じる。そこで挿入光源の出口よりビームラ インの端までが最大で80mになるようにし、その 外側に通路等を配置する案で実験エリアを設計し ている。第6図に現在検討中の蓄積リング棟案の 一部、即ち蓄積リング、遮蔽壁及び実験エリアの 平面図を示した。図では厚さ175cmの遮蔽壁を想 定しているが、挿入光源及び隣接する偏向磁石か らビームラインを取り出した場合、遮蔽を含め、 建物については今後とも検討を続ける予定である。 なお、挿入光源から得られる光ビームの50m先で

第4表 50m先での光ビームサイズと中心に於ける光子 強度

	アンジュレータ	ウィグラー	偏向磁石
ビームの大きさ(皿)			
水平	~ 2	$\sim \! 160$	
垂直	~1. 2	~ 6	~ 6
ビーム強度	(光子数/秒・	mm² • 0.1%	(bw)
	$\sim 1 \times 10^{15}$	\sim 5×10 ¹¹	\sim 3 \times 10 ¹⁰

の大きさと、光子の強度を第4表に示した。

実験の種類によってはより長いビームラインを 必要とする事が予想される。そこで将来,ビーム ラインを延長できるように敷地の整備を行なうこ とにした。将来300mの長さまで延長できるビー ムラインが2箇所(それぞれ挿入光源2本,偏向 磁石2本),1000mまで延長可能なビームライン が1箇所(挿入光源2本,偏向磁石1本)準備さ れている。

既に述べたように、SPring-8は兵庫県が開発 している播磨科学公園都市に設置されることが決 まっている。播磨科学公園都市は、兵庫県が西播 磨テクノポリス圏域に2000haを開発して建設し ようというもので、第1期として950haが造成中 である。大型放射光施設はその中心施設になるも ので、141ha 敷地が提供されることになっている。 第7図に播磨科学公園都市大型放射光キャンパス における施設の配置計画案を示した。蓄積リング の内側には約340mの標高を持つ三原栗山を残し, 蓄積リングはそれを取り巻くように建設する。蓄 積リングおよび実験準備棟,研究棟,管理棟を設 置する部分は290mレベルで平坦にし,将来長尺 ビームラインが設置できるようなスペースを残し てある。シンクロトロンとリニアックは、将来, それらの利用施設を建設する可能性を考えて,280 mレベルで整地した部分に建設する。なお,当初 は加速器棟、蓄積リング棟、研究棟、管理棟等を 建設し,宿舎などの建設は後送りになっている。



現在検討中の案であり、今後さらに変更されるものである。

1989年11月 79



第7図 SPring - 8 敷地と配置計画

6. 建設年次計画と利用計画

SPring - 8 の建設は順調に行けば1990年度か ら始まり,1995年度中に組み立て調整を終えて試 運転を開始する予定である。一方,当初立ち上げ る10本のビームラインは,'94,'95の2年で建設す る予定で,テスト実験は'96年には可能になろう。 残りのビームラインはこの後年次計画的に整備し て行くことになるが,具体的な計画は固まってい ない。

本施設は始めに述べたように、大学、国公立研、 産業界の共同利用に供される予定である。利用の 形も一般的なビームライン共同利用のほか、先端 研究のための一定期間内占有使用、特定ユーザー の専有使用や分析・解析サービス等が考えられて いる。本施設を用いて行なう研究課題については、 「検討委員会」「菊田研究会」で検討している。 すでに20をこす課題について、ビームラインの提 案等もなされている。しかし本施設はどんなに早 くても、7年後にしか利用できないので、最終的 な課題の決定はもっと後になろう。

本施設は、予定している性能を十分に発揮でき れば、X線領域の高輝度光源としては世界最高性 能のものになる。従ってその利用研究では、予想 されない新しい研究課題がでてくることが期待さ れる。これまで多くの加速器施設が、建設前に期 待したものと全く違った現象を発見し、新しい分 野の研究を開拓して、学問の発展に寄与してきて いる。

7. おわりに

SPring - 8 は、2 つの研究機関が協力して建 設を進めている。このようなことはわが国では初 めてであり、新しい試みと言えよう。また、その 利用にあたっては組織の違いにとらわれない運営 が必要であろう。本施設が完成した後でそれをど の様に運営するかは、優れた性能の施設を作るの と同じように重要な問題である。運営体制につい ても現在検討が進められている。 既に述べたように,建設計画,R&D計画及び 利用計画などは「検討委員会」で検討・評価する ことになっている。今後ともこの委員会及び下部 委員会の「加速器小委員会」「利用小委員会」で, 優れた施設にするための諸問題が検討される。 従ってここで述べた建設計画の内容は現時点のも であり,今後の検討で変更されることもある。な お,完成後の具体的な研究計画は「菊田研究会」 でも検討されている。

我々は各方面の助言を得ながら,世界第1級の 施設を建設したいと思っている。

参考文献

- 次世代大型X線光源研究会(代表 菊田惺志):次世 代大型X線光源研究会活動報告書(1989)
- 2) H.Kamitsubo et al.:Proc.European Acc.Conf. (Rome), 374 (1989)
- 3) K.Tsumaki et al.:Proc. Particle Acc. Conf. (Chicago), to be published (1989)
- 4) Catalogue of High Energy Accelerators,
- 5) J.C.Besson et al.: Proc. 3 rd Int. Conf. on Sync. Rad. Instr., RSI 60 1373 (1989)
- 6) Private communication by K.Huke
- 7) Conceptual Design Reports of APS and ESRF and private communications,